**Сведения о ведущей организации**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное исокращенное наименование ведущей организации | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики твердого тела Российской академии наук (ИФТТ РАН) |
| Адрес | 142432, г. Черноголовка, Московская обл., ул.Академика Осипьяна д.2, Россия |
| Телефон | 8(496)52 219-82 |
| Адрес электроннойпочты | adm@issp.ac.ru |
| Адрес сайта в сети«Интернет» (при наличии) | http://www.issp.ac.ru |
| Список основных публикацийработников организации по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние5 лет (не более 15). | [1] V. Usov, C.Ó. Coileáin, A.N. Chaika, I.V. Bozhko, V.N. Semenov, S. Krasnikov, O. Toktarbaiuly, S. Stoyanov, I.V. Shvets, Revealing electromigration on dielectrics and metals through the step-bunching instability,Physical Review B, 102 (2020) 035407.[2] S.V. Chekmazov, A.A. Smirnov, A.S. Ksenz, S.I. Bozhko, A.M. Ionov, S.G. Protasov, A.A. Kapustin, O.Y. Vilkov, E.A. Levchenko, Nontrivial evolution of the Sb(111) electronic and atomic structure after ion irradiation, Materials Letters, 240 (2019) 69-72.[3] S.I. Bozhko, K. Walshe, N. Tulina, B. Walls, O. Lubben, B.E. Murphy, V. Bozhko, I.V. Shvets, Surface modification on MoO2+x/Mo(110) induced by a local electric potential, Scientific Reports, 9 (2019) 6216.[4] V.Y. Aristov, A.N. Chaika, O.V. Molodtsova, S.V. Babenkov, A. Locatelli, T.O. Mentes, A. Sala, D. Potorochin, D. Marchenko, B. Murphy, B. Walls, K. Zhussupbekov, I.V. Shvets, Layer-by-Layer Graphene Growth on beta-SiC/Si(001), Acs Nano, 13 (2019) 526-535.[5] T. Vincent, S. Vlaic, S. Pons, T.Z. Zhang, H. Aubin, V.S. Stolyarov, A.S. Ksenz, A.M. Ionov, S.V. Chekmazov, S.I. Bozhko, D. Roditchev, Strong coupling and periodic potential at the Pb/Sb(111) interface, Physical Review B, 98 (2018) 155440.[6] O. Toktarbaiuly, V. Usov, C.O. Coileain, K. Siewierska, S. Krasnikov, E. Norton, S.I. Bozhko, V.N. Semenov, A.N. Chaika, B.E. Murphy, O. Lubben, F. Krzyzewski, M.A. Zaluska-Kotur, A. Krasteva, H. Popova, V. Tonchev, I.V. Shvets, Step bunching with both directions of the current: Vicinal W(110) surfaces versus atomistic-scale model, Physical Review B, 97 (2018) 035436.[7] N.N. Sergeeva, A.N. Chaika, B. Walls, B.E. Murphy, K. Walshe, D.P. Martin, B.D.O. Richards, G. Jose, K. Fleischer, V.Y. Aristov, O.V. Molodtsova, I.V. Shvets, S.A. Krasnikov, A photochemical approach for a fast and self-limited covalent modification of surface supported graphene with photoactive dyes, Nanotechnology, 29 (2018) 275705.[8] J. Sanchez-Barriga, I. Aguilera, L.V. Yashina, D.Y. Tsukanova, F. Freyse, A.N. Chaika, C. Callaert, A.M. Abakumov, J. Hadermann, A. Varykhalov, E.D.L. Rienks, G. Bihlmayer, S. Blugel, O. Rader, Anomalous behavior of the electronic structure of (Bi1-xInx)(2)Se-3)(2)Se-3 across the quantum phase transition from topological to trivial insulator, Physical Review B, 98 (2018) 235110.[9] S.I. Bozhko, A.S. Ksenz, A.M. Ionov, S.V. Chekmazov, E.A. Levchenko, Ab Initio Modeling of the Local Violation of a Peierls Transition at the Sb(111) Surface, Jetp Letters, 107 (2018) 780-784.[10] H.C. Wu, A.N. Chaika, M.C. Hsu, T.W. Huang, M. Abid, M. Abid, V.Y. Aristov, O.V. Molodtsova, S.V. Babenkov, Y.R. Niu, B.E. Murphy, S.A. Krasnikov, O. Lubben, H.J. Liu, B.S. Chun, Y.T. Janabi, S.N. Molotkov, I.V. Shvets, A.I. Lichtenstein, M.I. Katsnelson, C.R. Chang, Large positive in-plane magnetoresistance induced by localized states at nanodomain boundaries in graphene, Nature Communications, 8 (2017) 14453.[11] O. Lubben, S.A. Krasnikov, B. Walls, N.N. Sergeeva, B.E. Murphy, A.N. Chaika, S.I. Bozhko, I.V. Shvets, Nanoclusters and nanolines: the effect of molybdenum oxide substrate stoichiometry on iron self-assembly, Nanotechnology, 28 (2017) 205602.[12] V.Y. Aristov, O.V. Molodtsova, A.N. Chaika, Graphene Synthesized on Cubic-SiC(001) in Ultrahigh Vacuum: Atomic and Electronic Structure and Transport Properties, 2017. |

|  |  |
| --- | --- |
| Тип отзыва | Отзыв ведущей организации |
| ФИО лица, представившегоотзыв | Чайка Александр Николаевич |
| Ученая степень | кандидат физико-математических наук |
| Должность | старший научный сотрудник |
| ФИО лица, утвердившего отзыв | Левченко Александр Алексеевич доктор физ.-мат. наукЛевченко Александр Алексеевич |
| Ученая степень | доктор физ.-мат. наук |
| Должность | Директор |
| Полное исокращенное наименование ведущей организации | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики твердого тела Российской академии наук (ИФТТ РАН) |
| Адрес | 142432, г. Черноголовка, Московская обл., ул.Академика Осипьяна д.2, , Россия |
| Телефон | 8(496)52 219-82 |
| Адрес электроннойпочты | adm@issp.ac.ru |
| Адрес сайта в сети«Интернет» (при наличии) | http://www.issp.ac.ru |